

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Форш Павел Анатольевич
2	Дата рождения (полная)	13.05.1977
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор физико-математических наук наук, специальность – 01.04.10 – Физика полупроводников
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Доцент по кафедре
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	123182 Россия, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1. http://www.nrcki.ru/ nrcki@nrcki.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный Исследовательский Центр «Курчатовский институт»
	Ведомственная принадлежность организации	Полномочия учредителя от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации
	Тип организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение
	Наименование подразделения	Национальный Исследовательский Центр «Курчатовский институт»
	Должность	Главный ученый секретарь
7	<p>Основные публикации в области диссертационного исследования (для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 2-х в Scopus/WoS;</p> <p>для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 8 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 3-х в Scopus/WoS):</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minnekhanov A.A., Shvetsov B.S., Martyshov M.N., Nikiruy K.E., Kukueva E.V., Presnyakov M.Yu, Forsh P.A., Rylkov V.V., Erokhin V.V., Demin V.A., Emelyanov A.V. On the resistive switching mechanism of parylene-based memristive devices. Organic Electronics, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 74, с. 89-95. 2019. 2. Ilin A.S., Matsukatova A.N., Forsh P.A., Vygranenko Yu. Electrical Properties of Indium-Oxide Thin Films Produced by Plasma-Enhanced Reactive Thermal Evaporation. Semiconductors, издательство Izdatel'stva Nauka (Russian Federation), том 52, № 12, с. 1638-1641. 2018. 3. Pavlikov A.V., Forsh P.A., Sviakhovskiy S.E., Matsukatova A.N., Forsh E.A., Kazanskii A.G., Kashkarov P.K. Giant enhancement of free charge carrier concentration in boron-doped amorphous hydrogenated silicon under femtosecond laser crystallization. Applied Physics Letters, издательство American Institute of Physics (United States), том 113, с. 203103-1-203103-4. 2018. 4. Gavrilov Sergey A., Dronov Alexey A., Gavrilin Ilya M., Volkov Roman L., Borgardt Nickolay I., Trifonov Alexey Yu, Pavlikov Alexander V., Forsh Pavel A., Kashkarov Pavel K. Laser crystallization of germanium nanowires fabricated by electrochemical 	

deposition. Journal of Raman Spectroscopy, издательство John Wiley & Sons Inc. (United States), том 49, № 5, с. 810-816. 2018.

5. Vladimirova S., Krivetskiy V., Rumyantseva M., Gaskov A., Mordvinova N., Lebedev O., Martyshov M., Forsh P. Co₃O₄ as p-Type Material for CO Sensing in Humid Air. Sensors, издательство Molecular Diversity Preservation International (Switzerland), том 17, с. 2216-1-2216-13. 2017.
6. Ilin A.S., Ikin M.I., Forsh P.A., Belysheva T.V., Martyshov M.N., Kashkarov P.K., Trakhtenberg L.I. Green light activated hydrogen sensing of nanocrystalline composite ZnO-In₂O₃ films at room temperature. Scientific reports, издательство Nature Publishing Group (United Kingdom), том 7, № 1, с. 12204. 2017.
7. Zhigunov D.M., Il'in A.S., Forsh P.A., Bobyl' A.V., Verbitskii V.N., Terukov E.I., Kashkarov P.K. Luminescence of solar cells with a-Si:H/c-Si heterojunctions. Technical Physics Letters, издательство Maik Nauka/Interperiodica Publishing (Russian Federation), том 43, № 5, с. 496-498. 2017.
8. Zhigunov Denis M., Martyshov Mikhail N., Forsh Pavel A., Kamenskikh Irina A., Yakunin Sergey N., Kashkarov Pavel K. Structure-related current transport and photoluminescence in SiO_xN_y and SiN_x based superlattices with Si nanocrystals. Physica Status Solidi (A) Applications and Materials, издательство Wiley - V C H Verlag GmbbH & Co. (Germany), том 214, № 10, с. 1700040. 2017

8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты